# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-317033

(43)Date of publication of application: 31.10.2002

(51)Int.CI. COSG 61/00 CO9K 11/06

H05B 33/14 H05B 33/22

(21)Application number: 2001-121199 (22)Date of filing:

19 04 2001

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(72)Inventor: ARAKI KATSUMI

## (54) NEW POLYMER. LIGHT-EMITTING ELEMENT MATERIAL. AND LIGHT-EMITTING ELEMENT UTILIZING THE SAME

(57)Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a polymer having high carrier injecting properties, transportability. emission luminance, luminous efficiency and color purity in an electroluminescent element. SOLUTION: The new polymer is represented by formula (I) (wherein, R denotes a ≥7C alkyl group; (n) denotes a number of ≥5; R2 denotes a substituent group; a's denote each independently a number of 0-3; and Cb

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

denotes an aromatic hydrocarbon group).

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

Date of registration

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

# (12)公開特許公報(A) (11)特許出願公開番号

特開2002-317033 (P2002-317033A) (43)公開日 平成14年10月31日(2002.10.31)

| (51) Int. C1.7 | 識別記号                                    |              |        |          | F I        |        |           | 7-73-}*         | テーマコード(参考) |  |
|----------------|---|--------------|--------|----------|------------|--------|-----------|-----------------|------------|--|
| C 0 8 G        | 61/00                                   |              |        |          | C 0 8 G    | 61/00  |           | 3K007           |            |  |
| C 0 9 K        | 11/06                                   | 680          | )      |          | C 0 9 K    | 11/06  | 680       | 4J032           |            |  |
| H 0 5 B        | 33/14                                   |              |        |          | H 0 5 B    | 33/14  |           | В               |            |  |
|                | 33/22                                   |              |        |          |            | 33/22  |           | В               |            |  |
|                | 00/ 22                                  |              |        |          |            | 00/22  |           | D               |            |  |
|                | <b>東水陽</b> 七                            | <b>土無七</b>   | 請求項の数4 | OL       |            |        | (4.1      | レ<br>4頁)        |            |  |
|                | 甘且明水                                    | <b>不明</b> 不  | 明水海の数4 | <u> </u> |            |        | (王)       | 4月)             |            |  |
| (21) 出願番号      | 特願2001-121199 (P2001-121199)            |              |        |          | (71) 出願人   | 000005 | 201       |                 |            |  |
|                |   | 富士写真フイルム株式会社 |        |          |            |        |           |                 |            |  |
| (22) 出願日       | 平成13年4月19日(2001.4.19)                   |              |        |          |            |        |           | 5中沼210番地        |            |  |
|                | 1 1010 11111111111111111111111111111111 |              |        |          | (72) 発明者   |        |           |                 |            |  |
|                |   |              |        | - 1      | (12) 25714 |        |           | E -HATTON ON U. | er. Land   |  |
|                |   |              |        | - 1      |            |        |           | 5中沼210番地        | 岛工与具       |  |
|                |   |              |        | - 1      |            |        | ム株式会社     | IM              |            |  |
|                |   |              |        |          | (74)代理人    |        |           |                 |            |  |
|                |   |              |        | - 1      |            |        | 小栗        |                 |            |  |
|                |   |              |        | - 1      | Fターム(着     | 参考) 3K | .007 AB02 | ABO3 ABO4 AB    | 11 AB18    |  |
|                |   |              |        |          |            |        | CA01      | CBO1 DAO1 DB    | 03 EB00    |  |
|                |   |              |        | - 1      |            | 4J     | 032 BA12  | BB06 BB09 BC    | 02 CA04    |  |
|                |   |              |        | - 1      |            |        | CA12      | CB12 CD00 CG    | 00         |  |
|                |   |              |        |          |            |        | 31110     |                 | ••         |  |
|                |   |              |        |          |            |        |           |                 |            |  |
|                |   |              |        |          |            |        |           |                 |            |  |

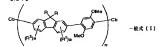
(54) 【発明の名称】新規重合体、それを利用した発光素子材料および発光素子

#### (57) 【要約】

【課題】電界発光素子においてキャリア注入性、輸送 性、発光輝度、発光効率、色純度の高い重合体を提供す

【解決手段】下記一般式(1)で表される重合体、該重 合体である発光素子材料及び該重合体を含有する発光素 子。

# 【化1】



(式中、Rは炭素数7以上のアルキル基を、nは5以上 の数を、R2は置換基を、aは独立に0から3までの数 を表す。 C b は芳香族炭化水素基を表す。)

## 【特許請求の範囲】

【化3】

【請求項1】下記一般式(1)で表される重合体。 化门

は芳香族炭化水素基を表す。) 【請求項3】下記一般式 (III) または (IV) で表され る重合体であることを特徴とする発光素子材料。

\* (一般式 (I) 中、Rは炭素数 7以上 20以下のアルキ ル基を、nは5以上の数を、R2は置換基を、aは独立 に0から3までの数を表す。Cbは芳香族炭化水素基を 表す。)

【請求項2】下記一般式(11)で表される重合体。

bは芳香族炭化水素基を表す。) [(t4]

(一般式 (IV) 中、nは5以上の数を、aは独立に0か ら3までの数を表す。R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>は各々置換基を表 す。bは独立に0から2までの数を表す。Arは上記の 基を表す。Cbは芳香族炭化水素基を表す。Hetはヘ テロ芳香族環を表す。)

【請求項4】一対の電極間に発光層もしくは発光層を含 50 【0001】

む複数の有機化合物層を形成した発光素子において、少 なくとも一層が請求項3記載の一般式(111)または(1 V) で表される重合体を含有する事を特徴とする発光素 子。

【発明の詳細な説明】

【発明の厲する技術分野】本発明は、高いキャリア注入 性、キャリア輸送性を育する重合体、半導体素子用材 料、それを利用した半導体業子、電気エネルギーを光に 変換して発光できる有機電界発光素子(以下、発光素子 と称する)用材料および発光素子に関し、電子回路、ト ランジスタや表示素子、ア・スアレイ、パックライト、 電子写真、照明光源、記録光源、読み取り光源、標識、 着板、インテリア、光通信アバイス等の分野に好適に使 用できる発光素子に関する。

#### [0002]

【従来の技術】今日、種々の表示素子に関する研究開発が活発であり、なかでも発光条子は、低電圧で高輝度の 発光を得ることができるため、将来有望な表示素子として注目されている。例えば、有機化合物の蒸着により有 機薄膜が積層された発光素子(粉層型素子)(アプライド フィジックス レターズ、5 8世巻、913頁、19 87年)や、ポリマー系素子(Nature、Vol. 356,5 March1992、47項)が知られている

じる場合があった。

【0004】また長時間経時後に駆動した場合や連続駆動時に、輝度の低下が起きやすいなど耐久性でも問題があり、ポリマー系素子は実用に供するには多くの問題を抱えていた。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】 本発明の目的は、製造 工程、加工性、大面積化に有利なポリマー系材料を使用 した場合の上記の問題と解決するべく、低電圧駆動、高 10 輝度、高発光効率の特性を有し、かつ高温保存耐久性を 有する新規な発光素子の提供にある。また電子デバイス 材料として、ホールまたは電子を高い移動度で注入・輸 送し、膜作成が簡便な材料を提供する事にある。 【00061】

【課題を解決するための手段】上記課題は下記の本発明 の手段により達成された。

(1) 下記一般式(I) で表される重合体。

[0 0 0 7]

【化5】

[(E, 6]]

【0008】(一般式(1)中、Rは炭素数7以上のアルキル基を、nは5以上の敷を、R\*は置換基を、aは 独立に0から3までの数を表す。Cbは汚香族炭化水素 基を表す、)

(2)下記一般式(II)で表される重合体。 【0009】

CO (R<sup>3</sup>)a (R<sup>3</sup>)a (R<sup>3</sup>)a (R<sup>3</sup>)a (R<sup>3</sup>)b N·N

~- \\ \frac{1}{12} \cdot \cdot

【0010】(式中、nは5以上の数を、R\*、R\*、R\*、R\* R\* は独立に0から3までの数を表す。bは独立に0から2までの数を表す。Arは上記の基を表す。Cbは汚番族炭化水素基を表す。)
(3)下記一般式(III)または(IV)で表される重合体であることを特徴とする展光素子材料。

【0011】 【化7】

【0014】 (一般式 (IV) 中、nは5以上の数を、a は独立に0から3までの数を表す。R1、R2、R3は各 々質換基を表す。 b は独立に 0 から 2 までの数を表す。 Arは上記の基を表す。Cbは芳香族炭化水素基を表 す。Hetはヘテロ芳香族環を表す。)

(4) 一対の電極間に発光層もしくは発光層を含む複数 の有機化合物層を形成した発光素子において、少なくと も一層が(3)に記載の発光素子材料を含有する事を特 徴とする発光素子。

#### [0 0 1 5]

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明 する。なお、本明細書において「~」はその前後に記載 される数値を、それぞれ最小値および最大値として含む 30 範囲を示す。

【0016】上述の様に、低電圧駆動、高輝度、高発光 効率の特性を有し、かつ高温保存耐久性を有する材料を 開発するため、本発明者は鋭意検討を重ねた結果。 上記 一般式(I)~(IV)に示されるような共重合成分を有 するポリフルオレン共重合体を開発するに至った。ポリ フルオレン共重合体およびその重合方法およびこれを使 用した素子等は、上述の米国特許、第5.777.07 0号、WO97/33323号、同97/05184 号、同99/48160号、同99/54385号、7 40 プライド フィジックス レターズ, 75巻, 3270 頁、1999年等で既に報告されている通りだが。上記 (1) および(2) に示されるような共重合成分を有す るポリフルオレン共重合体はこれまで全く報告されてい なかった。また、アプライドフィジックス レターズ. 75巻、3270頁、1999年には、2、5-ジデシ ルオキシ基を有する本発明の類似化合物が報告されてお り、種々の層構成のデバイスが検討されているが、フィ ルムでの発光波長420nmおよび448nm、半値幅

が高く低輝度であった。

【0017】次に本発明の一般式(1)の化合物につい て詳細に説明する。式中、Rとしては、それぞれ独立 に、炭素数7から20までのアルキル基が好ましく、フ ルオレン環の9位炭素原子と結合し炭素数7から20の 環構造を形成しても良い。 Rとして、炭素数8から16 までのアルキル基がより好ましく、ノルマルオクチル 基、2-エチルヘキシル基、ノルマルデシル基、ノルマ ルドデシル基、ノルマルヘキサデシル基、が特に好まし

【0018】R2としては、それぞれ独立に、炭素数1 から20までのアルキル基、炭素数1から20までのア ルキルオキシ基、炭素数1から20までのチオエーテル 基、炭素数1から20までのアルキルカルポニルオキシ 基またはシアノ基が好ましく、炭素数1から16までの アルキル基、炭素数1から16までのアルキルオキシ 基、炭素数1から16までのチオエーテル基、炭素数1 から16までのアルキルカルポニルオキシ基またはシア ノ基がより好ましく、メチル基、エチル基、ノルマルブ ロビル基、イソプロビル基、ノルマルブチル基、イソブ チル基、ターシャリーブチル基、ノルマルヘキシル基。 ノルマルオクチル基、2-エチルヘキシル基、ノルマル ドデシル基、ノルマルヘキサデシル基、メトキシ基、エ トキシ基、ノルマルプロピルオキシ基、イソプロピルオ キシ基、ノルマルプチルオキシ基、イソプチルオキシ 基、ノルマルヘキシルオキシ基、ノルマルオクチルオキ シ基、2-エチルヘキシルオキシ基、ノルマルドデシル オキシ基、ノルマルヘキサデシルオキシ基、メチルチオ 基、エチルチオ基、ノルマルプロピルチオ基、イソプロ ビルチオ基、ノルマルブチルチオ基、イソプチルチオ 基、ノルマルヘキシルチオ基、ノルマルオクチルチオ 基、2-エチルヘキシルチオ基、ノルマルドデシルチオ 69nmと依然発光波長は長く、素子性能でも駆動電圧 50 基、ノルマルヘキサデシルチオ基、メチルカルボニルオ

キシ基、エチルカルボニルオキシ基、ノルマルプロピル カルボニルオキシ基、イソプロビルカルボニルオキシ 基、ノルマルブチルカルボニルオキシ基、イソブチルカ ルポニルオキシ基、ノルマルヘキシルカルポニルオキシ 基、ノルマルオクチルカルポニルオキシ基、2-エチル ヘキシルカルポニルオキシ基、ノルマルドデシルカルボ ニルオキシ基、ノルマルヘキサデシルカルポニルオキシ 基、シアノ基が特に好ましい。

【0019】ポリマーの重合度nとしては、5~100 000が好ましく、10~10000がより好まし く、20~10000が特に好ましい。

【0020】aとしては、0~2が好ましく、0~1が より好ましく、0が特に好ましい。

【0021】Cbとしてはベンゼン環、ナフタレン環、 フェナンスレン環が好ましく、これ等の環は更に置換基 を有していても良い、置換基としては、アルキル基、ア リール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アラルキ ルオキシ基、アルキルチオ基、ニトロ基、トリフルオロ メチル基、カルポキシル基、ホルミル基、アルコキシカ ルポニル基、アシル基、アルケニル基、ジアルキルアミ ノ基が好ましく、メチル基、エチル基、ノルマルプロピ ル基、イソプロピル基、ノルマルプチル基、ターシャリ ープチル基、シクロプロピル基、フェニル基、メトキシ 基、エトキシ基、ノルマルプロポキシ基、イソプロポキ シ基、フェニルオキシ基、ペンジルオキシ基、メチルチ オ基、エチルチオ基、ノルマルプロピルチオ基、イソプ ロビルチオ基、ノルマルブチルチオ基、ニトロ基、トリ フルオロメチル基、カルポキシル基、ホルミル基、メト キシカルポニル基、エトキシカルボニル基、ノルマルプ ロポキシカルボニル基、イソプロポキシカルボニル基、 メチルカルボニル基、エチルカルボニル基、ノルマルブ ロビルカルポニル基、イソプロビルカルポニル基、ノル マルプチルカルポニル基、ビニル基、ジメチルアミノ基 がより好ましく、メチル基、エチル基、ノルマルプロピ ル基、ターシャリープチル基、シクロプロビル基、フェ ニル基、メトキシ基、エトキシ基、フェニルオキシ基、 ベンジルオキシ基、メチルチオ基、ニトロ基、トリフル オロメチル基、カルボキシル基、ホルミル基、メトキシ カルボニル基、エトキシカルボニル基、メチルカルボニ ル基、ビニル基、ジメチルアミノ基が特に好ましい。 【0022】次に本発明の一般式(II)の化合物につい て詳細に説明する。R¹としては、それぞれ独立に、炭 素数 1 から 2 0 までのアルキル基、一つ以上の硫黄原 子、窒素原子、酸素原子または珪素原子を含有する炭素 数1から20までのアルキル基、炭素数4から16まで のアルキルカルボニルオキシ基、炭素数6から16まで のアリール基が好ましく、フルオレン環の9位炭素原子 と結合して環を形成してもよく、形成される環として好 ましくは、炭素数5から20の環構造、あるいは硫黄原

0の環構造のものである。R1として、炭素数1から1 6までのアルキル基、炭素数1から16までのポリアル キレンオキシ基、炭素数4から8までのアルキルカルボ ニルオキシ基、炭素数6から14までのアリール基がよ り好ましく、炭素数8から16までのアルキル基が更に 好ましく、メチル基、エチル基、ノルマルプロビル基、 イソプロビル基、ノルマルブチル基、イソブチル基、ノ ルマルヘキシル基、ノルマルオクチル基、2-エチルヘ キシル基、ノルマルドデシル基、ノルマルヘキサデシル 10 基、メトキシエトキシエチル基、エトキシエトキシエチ ル基、メチルカルボニルオキシ基、エチルカルボニルオ キシ基、ノルマルプロビルカルボニルオキシ基、イソプ ロビルカルボニルオキシ基、ノルマルブチルカルボニル オキシ基、イソプチルカルボニルオキシ基、ノルマルへ キシルカルボニルオキシ基、フェニル基、ナフチル基、 アンスリル基が更に好ましく、ノルマルヘキシル基、ノ ルマルオクチル基、2-エチルヘキシル基、ノルマルド アシル基、ノルマルヘキサデシル基が特に好ましい。 【0023】R<sup>2</sup>、a、nとしては、一般式 (1) で述

20 べたのと同様の基がそれぞれ好ましい範囲として選択さ れる。

【0024】R3としては、アルキル基、アリール基、 アルコキシ基、アリールオキシ基、アラルキルオキシ 基、アルキルチオ基、ニトロ基、トリフルオロメチル 基、ジアルキルアミノ基が好ましく、メチル基、エチル 基、ノルマルプロビル基、イソプロビル基、ノルマルブ チル基、ターシャリーブチル基、シクロプロビル基、フ ェニル基、メトキシ基、エトキシ基、ノルマルプロポキ シ基、イソプロポキシ基、フェニルオキシ基、ベンジル 30 オキシ基、メチルチオ基、エチルチオ基、ノルマルプロ ピルチオ基、イソプロピルチオ基、ノルマルブチルチオ 基、ニトロ基、トリフルオロメチル基、ジメチルアミノ 基がより好ましく、メチル基、エチル基、ノルマルプロ ビル基、ターシャリープチル基、シクロプロビル基、フ "ュニル基、メトキシ基、エトキシ基、フェニルオキシ 基、ベンジルオキシ基、メチルチオ基、ニトロ基、トリ フルオロメチル基、ジメチルアミノ基が特に好ましい。 【0025】 bとしては、0~1が好ましく、0がより 好ましい。

40 【0026】Cbとしては、一般式(1)で述べたのと 同様の基が好ましい範囲として選択される。

【0027】次に本発明の一般式(111)の化合物につ いて詳細に説明する。R、R2、a、nとしては、一般 式(1)で述べたのと同様の基がそれぞれ好ましい範囲 として選択される。R4としては、炭素数1~9のアル キル基が好ましく、炭素数 1 ~ 6 のアルキル基がより好 ましく、炭素数1~4のアルキル基が特に好ましい。C bとしては一般式(I)で述べたのと同様の基が好まし い範囲として選択される。

子、窒素原子または酸素原子を含有する炭素数4から2 50 【0028】次に本発明の一般式(IV)の化合物につい

て詳細に説明する。R'、R2、a、n、Cb、bとして は、一般式(11)で述べたのと同様の基がそれぞれ好ま しい範囲として選択される。Hetとしては、トリアゾ ール、チアジアゾール、オキサジアゾール、トリアジ ン、ピラジン、ピリミジン、フラン、ピロール、チオフ ェン、オキサゾール、ピリジン、ベンゾフラン、フェナ ンスロリン等の環が好ましく、トリアゾール、チアジア ゾール、オキサジアゾール、トリアジン、フラン、ピロ ール、チオフェン、オキサゾール、ピリジン、フェナン スロリン等がより好ましく、トリアゾール、オキサジア 10 物例を示す。 ゾール、トリアジン、ピロール、チオフェン、オキサゾ ール、ピリジン、フェナンスロリン等が特に好ましい。 またこれ等の環は置換基を有していても良く、置換基と\*

\*しては、アルキル基、アリール基、シアノ基が好まし く、メチル基、エチル基、ノルマルプロピル基、イソブ ロビル基、ノルマルブチル基、イソブチル基、ターシャ リープチル基、フェニル基、シアノ基がより好ましく、 メチル基、エチル基、ノルマルプロピル基、イソプロピ ル基、ターシャリープチル基、フェニル基、シアノ基が 特に好ましい。

【0029】以下に本発明に用いられる一般式(1)~ (IV) で表される化合物のうち特に有効な代表的な化合

[0030]

【化9】

[0031]

【化10】

(7)

【0032】次に、上記の一般式(1)~(IV)で表さ れる重合体の製造方法について説明する。重合の方法 は、米国特許、第5.777.070号等に開示されて いる方法や、Macromolecules, 1997 年,30巻,7686-7691項等に記載されている 方法に従って行う事ができる。二官能の硼酸試薬と芳香 族ハロゲン化物のカップリング反応により重合を行う場 合、両モノマーの比率は、0.90:1.10~1.0 0:1.00が好ましく、0.95:1.05~1.0 40 ロゲン化物モノマーに対して、1~10当量が好まし 0:1.00がより好ましく、0.98:1.02~ 1.00:1.00が特に好ましい。使用する溶媒は、 各モノマーを少なくとも1%以上、好ましくは2%以上 溶解して溶液をなすものが好ましく、より好ましくは、 炭素数6~20までの芳香族基含有溶媒、特には、ベン ゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メシチレ ン、アニソール、またはこれらのフッ素化物が好ましい がトルエンが最も好適に使用される。使用する溶媒の量 は、重合の進行により増粘する反応混合物を効果的に概

に対して1~100mlが好ましく、3~50mlがよ り好ましく、5~20mlが特に好ましい。

【0033】使用する塩基としては、水溶性有機塩基が 好ましく、アルカリ金属炭酸塩、アルカリ金属炭酸水素 塩がより好ましく、炭酸カリウム、炭酸ナトリウムが特 に好ましい。使用する塩基の水中の濃度としては、1~ 10規定が好ましく、1~5規定がより好ましく、1~ 3規定が特に好ましい。使用する塩基の量としては、ハ く、1~5当量がより好ましく、1~3当量が特に好ま しい。使用する重合触媒としては、パラジウム触媒が好 ましく、Pd (II) 塩またはゼロ価パラジウム (Pd (0)) がより好ましく、酢酸パラジウム、またはテト ラキス (トリフェニルフォスフィン) パラジウムが特に 好ましい。使用する重合触媒の量としては、モノマー1 モルに対して、1×10-6~1×10-1モルが好まし く、1×10<sup>-5</sup>~1×10<sup>-2</sup>モルがより好ましく、1× 10-4~5×10-3モルが特に好ましい。

拌出来るように選択されるが、一般的にはモノマー1g 50 【0034】相関移動触媒の使用は、ボリマーの重合度

を上げる為に、非常に効果的である。使用する相関移動 触媒としては、アンモニウム塩、ホスホニウム塩、クラ ウンエーテル、クリプタン等が好ましく、テトラアルキ ルアンモニウムハライド、テトラアルキルアンモニウム 硫酸水素塩、テトラアルキルアンモニウムヒドロキシド 等がより好ましく、テトラノルマルプチルアンモニウム ハライド、ベンジルトリエチルアンモニウムハライド、 トリカプリルイルメチルアンモニウムクロライド等が特 に好ましい。使用する相関移動触媒の畳としては、モノ マー1モルに対し0.001モル~1モルが好ましく、 0. 01モル~0. 5モルがより好ましく、0. 05モ ル~0.3モルが特に好ましい。

【0035】重合反応の温度としては、使用する溶媒の 沸点付近が好ましいが、室温~170℃が好ましく、室 温~150℃がより好ましく、室温~130℃が特に好 ましい。重合時間としては、1~50時間が好ましく、 1~24時間がより好ましく、1~10時間が特に好ま しい。生成するポリマーの重合度としては、5~100 000が好ましく、10~10000がより好まし 散度は1.0~10が好ましく、1.0~7.0がより 好ましく、1.0~5.0が特に好ましい。

【0036】重合させたポリマーの精製法も特には限定 されないが、通常反応溶液を直接あるいは上記の重合に 適した溶媒により希釈した後、貧溶媒に滴下して再沈殿 精製する方法が好ましい。貧溶媒としては、アルコー ル、水、アセトン、酢酸エステル、アセトニトリル、炭 化水素系溶媒およびこれらの混合溶媒が好ましく、エタ ノール、メタノール、水、アセトン、酢酸エチル、アセ トニトリル、ヘキサン、ヘプタンおよびこれらの混合溶 媒がより好ましく、エタノール、メタノール、水、アセ トン、酢酸エチル、アセトニトリル、ヘキサンおよびこ れらの混合溶媒がより好ましい。

【0037】次に、一般式(I)~(IV)で表される重 合体であることを特徴とする発光素子材料について説明 する。なお、本発明において発光素子材料とは、発光性 化合物単独の役割、又は電子注入性化合物、電子輸送性 化合物、ホール注入性化合物、ホール輸送性化合物、お よびホスト化合物といった複数の役割を担う材料を意味 する。重合体は単一の成分からなるホモポリマーであっ 40 ても良いし、多成分からなる共重合体であっても良い。 また上述の様に、特定の可溶溶媒中でモノマーを重合さ せて得られたポリマーをそのまま、あるいは必要に応じ て精製したのちに使用しても良い。またキャリア移動性 の観点から一般式(1)~(IV)で表される重合体が電 子注入性化合物、電子輸送性化合物、ホール注入性化合 物、ホール輸送性化合物、ホスト化合物およびこれらの 複数の役割を担う事が好ましい。発光素子用材料または 半導体素子用材料としてのポリマーのキャリア移動件の 度合いも特には限定されないが、電界強度400~10 50 【0044】本発明の有機化合物層の電子移動度は駆動

00 ((V/cm) 1/2) の範囲で、電子移動度および ホール移動度ともに1、0×10-8cm2・V-1・s-1 以上の値が好ましく、1. 0×10<sup>-7</sup>c m<sup>2</sup>·V<sup>-1</sup>·s 「以上の値がより好ましく、1.0×10-cm2・V -1 · s -1以上の値が特に好ましい。

【0038】次に、一対の電極間に発光層もしくは発光 層を含む複数の有機化合物薄層を形成した発光素子にお いて、少なくとも一層が一般式(I)~(IV)で表され る重合体を含有する発光素子ついて説明する。発光素子 用材料または半導体素子用材料としてのポリマーのキャ リア移動性の度合いも特には限定されないが、電界強度 400~1000 ((V/cm) 1/2) の範囲で、電子 移動度およびホール移動度ともに 1.0×10-8 c m<sup>2</sup> · V-1·s-1以上の値が好ましく、1.0×10-7cm 2・V-1・s-1以上の値がより好ましく、1.0×10 -6 c m<sup>2</sup> · V-1 · s -1以上の値が特に好ましい。

【0039】本発明の発光素子は、陽極と陰極の一対の 電極間に、発光層もしくは発光層を含む複数の有機化合 物薄層を形成した構成であり、発光層のほか保護層など く、20~10000が特に好ましい。ポリマーの分 20 を有してもよく、またこれらの各層はそれぞれ他の機能 を備えたものであってもよい。各層の形成にはそれぞれ 種々の材料を用いることができる。

> 【0040】有機化合物層は、電子注入性化合物、電子 輸送性化合物、電子注入性および輸送性を兼ねる化合物 (電子注入性兼輸送性化合物)、ホール注入性化合物、 ホール輸送性化合物、ホール注入性およびホール輸送性 を兼ねる化合物(ホール注入性兼輸送性化合物)、電子 注入性兼輸送性とホール注入性兼輸送性のそれぞれを兼 ねる化合物(電子注入性兼輸送性化合物兼ホール注入性 30 兼輸送性化合物)、発光性化合物、ホスト化合物、電子 供与性ドーパント、電子受容性ドーパント等から選択さ れる幾つかの材料を含有して使用するものである。

【0041】本発明の有機化合物層は高分子化合物のみ で構成されてもよいし、高分子化合物と低分子化合物の 混合物で構成されていてもどちらでもよい。

【0042】本発明の発光素子に使用する有機化合物層 中に含まれる、電子注入性化合物、電子輸送性化合物、 電子注入性兼輸送性化合物、ホール注入性化合物、ホー ル輸送性化合物、ホール注入性兼輸送性化合物、電子注 入性兼輸送性化合物兼ホール注入性兼輸送性化合物、発 光性化合物、ホスト化合物、電子供与性ドーパント、電 子受容性ドーパントなどのこれらの化合物は、巻つかの 機能を担う性質、部分が一つの分子中に含有されていて もよい。またそれぞれの機能が、別々の分子に分かれて いてもよい。

【0043】電子注入性兼輸送性化合物兼ホール注入性 兼輸送性化合物が担う電子注入性および輸送性、ホール 注入性および輸送性の寄与の割合は化合物により異なる 値をとり得る。

電圧の観点から、電界強度400~1000 ((V/c m) 1/2) の範囲で、3×10-8cm2・V-1・s-1以上 の値を有することが好ましく、1×10-7cm2・V-1 · s <sup>-1</sup>以上の値がより好ましく、5×10<sup>-6</sup> c m<sup>2</sup> · V -1 · s -1以上の値が更に好ましい。

【0045】有機化合物層の電子移動度は、電子注入性 化合物、電子輸送性化合物、電子注入性兼輸送性化合 物、ホール注入性化合物、ホール輸送性化合物、ホール 注入性兼輸送性化合物、電子注入性兼輸送性化合物兼ホ ール注入性兼輸送性化合物の該層を構成するそれぞれの 化合物自身がもつ電子移動度により規定されるが、これ ら化合物同士の混合量によっても電子移動度が規定され る。該電子移動度の値を有する化合物としては、主にへ テロ原子含有有機化合物、電子輸送性有機化合物、有機 化合物錯体、有機金属錯体、有機金属化合物、電荷移動 錯体、およびこれらの重合体、共役系ポリマー、導電性 ポリマー等が知られているが、上記電子移動度の値を満 たすものであれば特に限定される事はなく、適宜選択し て使用できる。上記の例の中で、含窒素有機化合物、含 酸素有機化合物、含硫黄有機化合物、含硼素有機化合 物、含珪素有機化合物、含燐有機化合物、液晶性有機化 合物、結晶性有機化合物、有機化合物錯体、有機金属錯 体、有機金属化合物、電荷移動錯体、共役系ポリマー等 が好ましく、中でもヘテロ原子含有芳香族有機化合物、 ヘテロ原子含有芳香族有機化合物の電荷移動錯体、有機 金属化合物、雷荷移動錯体、液晶性有機化合物、結晶性 有機化合物およびこれらの重合体、共役系ポリマー等が より好ましい。

【0046】本発明における電子移動度の測定は、タイ ム オブ フライト (以下、TOFと称する) 法により 測定した。TOF法については、シンセティック メタ ルズ (Synth, Met.) 111/112, (2000) 331ページの記載を 参照できる。

【0047】本発明の有機化合物層に用いられる化合物 のイオン化ポテンシャルは、通常は最小値をもつ化合物 により決まる。該化合物のイオン化ポテンシャルはホー ル注入性の観点で4.7eV以上10.0eV以下であ ることが好ましく、4.8eV以上10.0eV以下で あることがより好ましく、4.9eV以上10.0eV 以下であることが更に好ましい。本発明の有機化合物層 40 に用いられるアリールアミン誘導体のイオン化ポテンシ ャルも同様にホール注入性の観点で5.0 e V以上1 0.0eV以下であることが好ましく、5.1eV以上 10.0eV以下であることがより好ましく、5.2e V以上10.0eV以下であることが更に好ましい。 【0048】本発明の有機化合物層を使用する場合には PEDOT-PSS膜 (ポリエチレンジオキシチオフェ ンーポリスチレンスルホン酸ドープ体)のような水系塗 布した薄膜の上に本発明の有機化合物層を設けてもよ い。本発明の有機化合物層を設ける場合には、低分子蒸 50 理、プラズマ処理などが効果的である。

着プロセスでもよいし、塗布プロセスでもよい。塗布プ ロセスの場合、好ましい塗布溶媒としては水、メタノー ル、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、ブ タノール、蟻酸、酢酸、メチルセロソルブ、エチルセロ ソルブ、エチレングリコール、プロピレングリコール、 ジオキサン、ペンゼン、トルエン、キシレン、クロロホ ルム、ジクロロメタン、ジクロロエタン、テトラヒドロ フランおよびこれらの混合溶媒が好ましく、水、メタノ ール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、 酢酸、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、エチレン グリコール、ジオキサン、トルエン、クロロホルム、ジ クロロメタン、ジクロロエタン、テトラヒドロフランお よびこれらの混合溶媒がより好ましい。

16

【0049】陽極はホール注入性化合物、ホール輸送性 化合物、ホール注入性兼輸送性化合物、ホスト化合物な どにホールを供給するものであり、金属、合金、金属酸 化物、導電性化合物、またこれらの混合物などを用いる ことができ、好ましくは仕事関数が4 e V以上の材料で ある。具体例としては、酸化スズ、酸化亜鉛、酸化イン 20 ジウム、錫ドープ酸化インジウム (ITO)等の導電性 金属酸化物、もしくは金、銀、クロム、ニッケル等の金 属、およびこれらの金属と導電性金属酸化物との混合 物、または無機導電性物質(積層物、沃化銅、硫化銅な ど)、有機導電性材料(ポリアニリン、ポリチオフェ ン、ポリピロールなど)、およびこれらと1丁0との積 層物などが挙げられ、好ましくは、導電性金属酸化物、 有機導電性材料、またはこれらの積層物であり、生産 性、高導電性、透明性等の点からITOまたはITO/ PEDOT-PSS積層物がより好ましい。陽極の膜度 は材料により適宜選択可能であるが、通常10nm~5 μmの範囲のものが好ましく、より好ましくは、50n m~1μmであり、更に好ましくは100nm~500 nmである。

【0050】陽極は通常、ソーダライムガラス、無アル カリガラス、透明樹脂基板などの上に層形成したものが 用いられる。ガラスを用いる場合、その材質について は、ガラスからの溶出イオンを少なくするため、無アル カリガラスを用いることが好ましい。また、ソーダライ ムガラスを用いる場合、シリカなどのバリアコートを施 したものを使用する事が好ましい。基板の厚みは、機械 的強度を保つのに十分であれば特に制限はないが、ガラ スを用いる場合には、通常 O. 2 mm以上、好ましくは 0. 7mm以上のものを用いる。陽極の作成には材料に よって種々の方法が用いられるが、例えば1T0の場 合、電子ピーム法、スパッタリング法、抵抗加熱基着 法、化学反応法(ゾルーゲル法など)、1 T〇分散物の 塗布などの方法で膜形成される。陽極は洗浄その他の処 理により、素子の駆動電圧を下げて発光効率を高めるこ とも可能である。例えば1丁〇の場合、UV-オゾン処

【0051】陰極は電子注入性化合物、電子輸送性化合 物、電子注入性兼輸送性化合物、ホスト化合物などに電 子を供給するものであり、これらの化合物やマトリクス 化合物との密着性やイオン化ポテンシャル、安定性等を 考慮して選択される。陰極の材料としては金属、合金、 金属ハロゲン化物、金属酸化物、電気伝導性化合物、有 機金属塩またはこれらの混合物または積層物を用いるこ とができ、具体例としてはアルカリ金属(例えばLi、 Na、K等)およびそのフッ化物または酸化物、アルカ リ土類金属(例えばMg、Ca等)およびそのフッ化物 10 または酸化物、金、銀、鉛、アルニウム、ナトリウムー カリウム合金またはそれらの混合金属、リチウムーアル ミニウム合金またはそれらの混合金属、マグネシウムー 銀合金またはそれらの混合金属、インジウム、イッテリ ビウム等の希土類金属、アルカリ金属およびアルカリ土 類金属の有機化合物塩等が挙げられ、好ましくは仕事関 数が4eV以下の材料であり、より好ましくはアルミニ ウム、リチウムーアルミニウム合金またはそれらの混合 金属、マグネシウムー銀合金またはそれらの混合金属、 有機リチウム塩等である。

【0052】陰極は、上記化合物および混合物の単層構造だけでなく、上記化合物および混合物を含む積層構造を取ることもできる。陰極の膜厚は材料により適直違択可能であるが、通常10nm~5μmの範囲が好まし

く、より好ましくは50 nm − 1 μ m であり、更に好ましくは100 nm − 1 μ m である。陸極の作製には電子ビーム法、スパッタリング法、抵抗加熱素着法、コーティング法などの方法が用いられ、金属を単体で蒸着することも、三成分以上の時に、蒸着することもできる。また複数の金属を同時に蒸着して合金電板を形成すること 30 も可能であり、またあらかじめ調整した合金を蒸着させてもよい。陽極および陰極のシート抵抗は低い方が好ましく、15 Ω/□以下が好ましい。

【0053】発光性化合物は、電界印加時に陽極またはホール注入層、ホール輸送層からホールを注入することができると共に陰極または電子注入層、電子輸送層から電子を注入することができる機能や、注入された電荷を移動させる機能、ホールと電子の再結合の場を提供して発光させる機能を有するものであれば何でもよく、一重項助起子または三重短助起子のいずれから発光するもののでもよい。発光性化合物として好ましくは共役系不飽和化合物またはオルトメタル化金陽錯体またはボルフィリン金属結体が挙げられるが、他の発光材料を併用して用いてもよい。発光材料は重合体を用いても低分子材料を用いてもよい。異体的には下記に挙げる化合物等を用いることができる。

【0 05 4】(a) ペングオキサゾール、ペンゾイミダゾール、ペンゾチアゾール、スチリルベンゼン、ポリフェニル、プラェニルブタジエン、テトラフェニルアダジエン、ナフタルイミド、クマリン、ペリレン、ペリノン、

オキサジアゾール、アルダジン、シクロベンタジエン、 ビススチリルアントラセン、キナクリドン、ピロロビリ ジン、チアジアゾロピリジン、シクロベンタジエン、ス チリルアミン、芳香族ジメチリディン化合物、ピレン、 およびこれらの誘導体など。

(b) 8-キノリノールおよびその誘導体の金属錯体や希 土類錯体に代表される各種金属錯体など。

(c)ポリチオフェン、ポリフェニレン、ポリフルオレ ン、ポリフェニレンビニレン、およびこれらの置換され ト たポリマー化合物など

(d) オルトメタル化金属錯体またはポルフィリン金属錯体など。

【0055】前記化合物の中でも、好ましく用いられる 化合物は以下のとおりである。スチリルペンゼン、ボリ フェニル、ジフェニルブタジエン、テトラフェニルブタ ジエン、クマリン、ペリレン、オキサジアゾール、ピス スチリルアントラセン、キナクリドン、シクロペンタジ エン、スチリルアミン、芳香族ジメチリディン化合物、 ピレン、およびこれらの誘導体など;8-キノリノール 20 およびその誘導体など。第一キノリノール お母金属譜体など:ボリチオフェン、ボリフェニレン、 ボリフルオレン、ボリフェニレンど、およびこれ

らの置換されたポリマー化合物など:オルトメタル化金

属錯体またはポルフィリン金属錯体など:

【0056】前記化舎物の中でも、更に好ましく用いられる化合物は以下のとおりである。スチリルペンゼン、ポリフェニル、ジフェニルブクジエン、テトラフェニルブタジエン、クマリン、ペリレン、オキサジアゾール、ピススチリルアントラセン、スチリルアミン、芳智族ジなど、8-キノリノールおよびその誘導体や希上類は体代表される各種の議論体など、ボリテオフェン、ポリフェニレン、ポリフェニレン、ポリフェニレン、ポリフェニレンとピニレンおよびこれらの置換されたポリマー化合物など、オルトメタル化金属影体など、オルトメウィーは今の機会は、ボリテオフェン、ポリフェニレンピニレンおよびこれらの置換されたポリマー化合物など、オルトメタル化金属が検またはボルフィリン金属が

【0057】有機化合物層の膜厚は特に限定されるものではないが、適常1 $nm\sim5um$ の範囲のものが好ましく、より好ましくは5 $nm\sim1um$ であり、更に好ましくは1 $0nm\sim500nm$ である。

体など・

【0058】有機化合物層の形成方法は、特に限定されるものではないが、抵抗加熱蒸着、電子ピーム、スパックリング、分子積層は、コーティングは、スピンコート法、キャスト法、ディップコート法など)、インクジェット法、印刷法、転写法、18(ラングミュアーブロジェット) 法などの方法が用いられ、好ましくは抵抗加熱蒸着、コーティング法、インクジェット法、印刷法である。コーティング法、インクジェット法、印刷法の場合、機脂成分と共に溶解または分散することができ、場50 脂成分としては例えば、ボリ塩化ビニル、ボリカーボネ

ート、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリ ブチルメタクリレート、ポリエステル、ポリスルホン、 ポリフェニレンオキシド、ポリブタジエン、ポリ (Nー ビニルカルバゾール)、炭化水素樹脂、ケトン樹脂、フェノキシ樹脂、ポリアミド、エチルセルロース、酢酸ビ ニル、ABS樹脂、ポリウレダン、メラミン樹脂、不飽 和ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、エポキシ樹脂、シ リコン褐脂などが挙げられる。

【0059】ホール注入性、ホール輸送性化合物は、陽 極からホールを注入する機能、ホールを輸送する機能、 陰極から注入された電子を障壁する機能のいずれか有し ているものであればよく、重合体を用いても低分子化合 物を用いてもよい。その具体例としては、カルバゾー ル、トリアゾール、オキサゾール、オキサジアゾール、 イミダゾール、ポリアリールアルカン、ピラゾリン、ピ **ラゾロン、フェニレンジアミン、アリールアミン、アミ** ノ置換カルコン、スチリルアントラセン、フルオレノ ン、ヒドラゾン、スチルベン、シラザン、およびこれら の誘導体、芳香族第三級アミン化合物、スチリルアミン 化合物、芳香族ジメチリディン系化合物、ポルフィリン 20 系化合物、ポリシラン系化合物、ポリ(N-ビニルカル バゾール)誘導体、アニリン系共重合体、チオフェン化 合物、ポリチオフェン、置換および無置換ポリチオフェ ンーポリスチレンスルホン酸混合物等の導電性高分子オ リゴマー等が挙げられ、またこれらの混合物であっても よい。とりわけカルパゾール、トリアゾール、オキサゾ ール、オキサジアゾール、イミダゾール、フェニレンジ アミン、アリールアミン、フルオレノン、スチルベン、 シラザン、およびこれらの誘導体、芳香族第三級アミン 化合物、スチリルアミン化合物、芳香族ジメチリディン 系化合物、アニリン系共重合体、チオフェン化合物、ポ リチオフェン、置換および無置換ポリチオフェンーポリ スチレンスルホン酸混合物等の導電性高分子オリゴマー 等がより好ましい。この中でも、ホール輸送機能の点で カルバゾール、トリアゾール、オキサゾール、オキサジ アゾール、イミダゾール、フェニレンジアミン、アリー ルアミン、フルオレノン、シラザン、およびこれらの誘 導体、芳香族第三級アミン化合物、チオフェン化合物、 置換および無置換ポリチオフェンーポリスチレンスルホ ン酸混合物等の導電性高分子オリゴマー等が更に好まし 40

【0060】電子注入性化合物、電子輸送性化合物、電子注入性兼輸送性化合物の材料は、陰極から電子を注入 する機能、電子を輸送する機能、器極から注入されたホールを障壁する機能のいずれか有しているものであれば よい。具体例としては、ピリジン、ピラジン、キノリン、キノチリン、キノエフスロリン、トリアジン、チ エノピラジン、ベンズイミがゾール、ベンズオキサゾール、ベンブトリアンル、ア・リア・リア・ルフ・ドリアソール、オナサゾール、オナサゾール、フルオレノ・フルオレノ・フルオレノ・フルオレノ・フルオレノ・フルオレノ・フルオレノ・フルオレノ・フルオレノ・ファ

ン、アントラキノジメタン、アントロン、ジフェニルキ ノン、チオピランジオキシド、カルビジイミド、フルオ レニリデンメタン、ジスチリルピラジン、フタロシアニ ン、およびこれらの誘導体、ナフタレンペリレン等の複 素環テトラカルボン酸無水物、8-キノリノール誘導体 の金属錯体やメタルフタロシアニン、ベンゾオキサゾー ルやベンゾチアゾールを配位子とする各種金属錯体等が 挙げられる。混合物またはポリマーとして使用してもよ い。とりわけピリジン、ピラジン、キノリン、キノキサ 10 リン、フェナンスロリン、トリアジン、フェナントリジ ン、トリアゾール、オキサゾール、オキサジアゾール、 フルオレノン、フタロシアニン、およびこれらの誘導 体、ナフタレンペリレン等の複素環テトラカルボン酸無 水物、8-キノリノール誘導体の金属錯体やメタルフタ ロシアニン、ベンゾオキサゾールやベンゾチアゾールを 配位子とする各種金属錯体等およびこれらのポリマーが より好ましい。この中でもピリジン、ピラジン、キノリ ン、キノキサリン、フェナンスロリン、トリアジン、ト リアゾール、オキサゾール、オキサジアゾール、フルオ レノン、フタロシアニン、およびこれらの誘導体、8-キノリノール誘導体の金属錯体やメタルフタロシアニン およびこれらのポリマーが更に好ましい。

【0061】本発明における有機化合物層に含有される アリールアミンおよびその誘導体は、通常はホール注入 性およびホール輸送性化合物、ホスト化合物としても作用 するが、高分子になると電子輸送性化合物としても作用 することが知られている。アリールアミンおよびその誘導 体、Nーフェニルカルパゾールおよびその誘導体が好ま 30 しく、中でもNーフェニルカルパゾールおよびその誘導 体がより好ましく用いられる。これらは低分子化合物で あっても高分子化合物であってもよい。

【0062】保護層の材料としては、水分や酸素等の素子劣化を促進するものが素子内へ侵入するのを防止する機能を有しているものであればよい、その具体例としては、In、Sn、Pb、Au、Cu、Ag、Al、Ti、Ni等の金属、MgO、SiO、SiO<sub>2</sub>、Al₂O。、GeO、NiO、CaO、BaO、Fe₂O。、Y₂O。、TiO₂等の金属酸化物、MgFs、LiF、AlFs、CaF₂等の金属フッ化物、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリメチルメタクリレート、ポリイミド、ポリカレア、ポリテトラフルオロエチレン、ポリウロートリフルオロエチレン、ポリクロロシフルオロエチレン

ボリウレア、ボリテトラフルオロエチレン、ボリクロロ トリフルオ ロエチレン、ボリジクロロジフルオロエチレン、クロロトリフルオロエチレンとうか エチレンとの共重合体、テトラフルオロエチレンと少な くとも1種のコモノマーとを含むモノマニ温合物を共重 合させて得られる共重合体、共重合主鎖に環状構造を する含フッ素共重合体、吸水準1%以上の吸水性物質、 吸水率0.1%以下の防湿件物質をが壊げられる。

50 【0063】保護層の形成方法についても特に限定はな

く、例えば化学蒸着法(CVD法)、真空蒸着法、スパ ッタリング法、反応性スパッタリング法、分子線エピタ キシ (MBE) 法、クラスターイオンピーム法、イオン プレーティング法、プラズマ重合法(高周波励起イオン プレーティング法)、プラズマCVD法、レーザーCV D法、熱CVD法、ガスソースCVD法、インクジェッ ト法、印刷法、コーティング法、転写法を適用できる。 [0 0 6 4]

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明を具体的に説明 するが、本発明はこれにより限定されるものではない。 なお下記実施例において以下の測定を行った。重量平均 分子量は、ゲル濾過法を用いてテトラヒドロフランを溶 離液としてポリスチレン換算したものである。イオン化 ポテンシャルは紫外線光電子分析装置AC-1により測定 した。溶液の吸収は、クロロホルム中、1×10-7mo 1/1の濃度のときのものである。エネルギーギャップ は、溶液吸収の長波端の波数をエネルギーに換算して求 めた。電子親和力はイオン化ポテンシャルの値からエネ ルギーギャップの値を差して求めた。膜の発光極大波長 は、ポリマー20mgをクロロホルム2mlに溶かした 20 溶液をガラス基板上に5000rpm×20秒の条件に てスピンコート塗布し、真空乾燥して得られた膜を、 ? 55nmの光で励起した時に測定したものである。ガラ ス転位温度はDSCを用いて通常の方法により測定した。 実施例 1 (例示化合物 1 の合成)

窒素気流下、2,7-ピス(4,4,5,5-テトラメ チルー1.3.2ージオキサポロラン-2-4ル)-9. 9-ジーノルマルオクチルフルオレン1、6064g (2.50mmol)、1,4-ジプロモー2,5-ジ メトキシベンゼン0, 7399g(2, 50mmo 、トルエン11ml、トリカプリルイルメチルアン モニウムクロライド 0. 1 2 5 g (0. 3 1 mm ol) を入れ室温で10分攪拌した。次いでテトラキス(トリ フェニルフォスフィン) パラジウム 0.015g(0. 0 1 2 5 mm o1: 0. 2 5 m o 1%) を加え、室温で1 0分攪拌した。次いで2M炭酸ナトリウム水溶液4.1 7 m l を加え、緩やかに還流しながら二時間強く攪拌し た。次いでトルエン4.17mlを加え、還流しながら 更に15時間攪拌した。次いでトルエン5mlを加え還 流しながら更に9時間攪拌した。次いで、末端処理剤と 40 して、2-フェニルー1,3,2-ジオキサポリナン 0. 1825g(1. 125mmol)を加え15時間 還流しながら攪拌し、次いでプロモベンゼン0,083 g (0.53mmol) を加え5時間還流しながら攪拌 した。反応終了後、トルエン20mlを加え希釈した 後、反応混合物を室温まで冷却し、メタノール:水=1 0:1(容積比)の溶液の中に攪拌しながら滴下し、再 沈殿精製した。得られたポリマーを濾過して集めた後、 メタノール、水で数回洗浄した。次いで室温で真空乾燥 して、例示化合物 1 のポリマーを得た。重量平均分子量 50 (Mn) 4 7 0 0 0 、イオン化ポテンシャル (JP) 5 。

(Mw) 8000 (ポリスチレン換算)、数平均分子量 (Mn) 5000 (ポリスチレン換算)、イオン化ポテ ンシャル (IP) 5.85eV、電子親和力2.81e V、エネルギーギャップ 3. 0 4 e V、溶液の発光極大 波長4 [ 4 nm、吸収極大波長358 nm (クロロホル ム中、1×10<sup>-7</sup>mol/1)、膜の発光極大波長42 0 nm、膜の吸収極大波長365nm、ガラス転位温度 172°C.

【0065】実施例2(例示化合物2の合成)

実施例1の1, 4-ジブロモー2, 5-ジメトキシベン ゼンを2,6-ジブロモピリジンに代えた以外は実施例 1と同様にして重合、精製を行い、例示化合物2の重合 体を得た。重量平均分子量 (Mw) 34000、数平均 分子量(Mn)14000、イオン化ポテンシャル() P) 5、90eV、電子親和力2、70eV、エネルギ ーギャップ3.20eV、溶液の発光極大波長383n m、吸収極大波長368nm、半値幅32nm(クロロ ホルム中、1×10-7mol/1)、膜の発光極大波長 408nm、吸収極大波長370nm、ガラス転位温度 1120.

【0066】実施例3 (例示化合物3の合成)

実施例1の1、4-ジプロモー2、5-ジメトキシベン ゼンを2.5-ジプロモビリジンに代えた以外は実施例 1と同様にして重合、精製を行い、例示化合物3の重合 体を得た。重量平均分子量 (Mw) 100000、数平 均分子量 (Mn) 35000、イオン化ポテンシャル (IP) 5.87eV、電子親和力2.99eV、エネル ギーギャップ 2.88eV、溶液の発光極大波長418 nm、吸収極大波長386nm、半値幅40nm (クロ 30 ロホルム中、1×10-7mol/1)、膜の発光極大波 長429nm、吸収極大波長388nm。

【0067】実施例4(例示化合物4の合成)

実施例1の1, 4-ジブロモ-2, 5-ジメトキシベン ゼンを1、4-ジプロモテトラフルオロベンゼンに代え た以外は実施例1と同様にして重合、精製を行い、例示 化合物4の重合体を得た。重量平均分子量 (Mw) 2 4 000、数平均分子量(Mn)10000、イオン化ポ テンシャル (IP) 5.62eV、電子親和力2.40e V、エネルギーギャップ 3. 22 e V、溶液の発光極大 波長400nm、吸収極大波長341nm、半値幅63 nm (クロロホルム中、1×10<sup>-7</sup>moi/1)、膜の 発光極大波長408nm、吸収極大波長347nm、ガ ラス転位温度58℃。

【0068】実施例5 (例示化合物5の合成) 実施例1の1、4-ジプロモー2、5-ジメトキシベン ゼンを2,5-ビス(4-プロモフェニル)-1,3. 4-オキサジアゾールに代えた以外は実施例1と同様に して重合、精製を行い、例示化合物5の重合体を得た。 重量平均分子量(Mw)153000、数平均分子量

86 e V、電子親和力2.86 e V、エネルギーギャッ プ3.00eV、溶液の発光極大波長410nm、吸収 極大波長376nm、(クロロホルム中、1×10<sup>-7</sup>m ol/1)、膜の発光極大波長446nm、吸収極大波 長369nm、ガラス転位温度51℃。

## 【0069】実施例6(例示化合物7の合成)

実施例1の1、4-ジプロモー2、5-ジメトキシベン ゼンを2,5-ジプロモピラジンに代えた以外は実施例 1と同様にして重合、精製を行い、例示化合物7の重合 体を得た。重量平均分子量 (Mw) 25000、数平均 10 分子量 (Mn) 12000、イオン化ポテンシャル (I P) 5. 92 e V、電子親和力3. 19 e V、エネルギ ーギャップ 2. 73 e V、溶液の発光極大波長 4 4 3 n m、吸収極大波長420nm、(クロロホルム中、1× 10<sup>-7</sup>mol/1)、膜の発光極大波長450nm、吸 収極大波長428nm、ガラス転位温度75℃。

【0070】実施例7(例示化合物8の合成) 実施例1の1,4-ジプロモー2.5-ジメトキシベン ゼンを1,3-ジプロモベンゼンに代えた以外は実施例 1と同様にして重合、精製を行い、例示化合物 8 の重合 20 体を得た。重量平均分子量 (Mw) 15000、数平均 分子量 (Mn) 8000、イオン化ポテンシャル (IP)

5. 62 e V、電子親和力 2. 26 e V、エネルギーギ ャップ3.36eV、溶液の発光極大波長367nm. 吸収極大波長343nm、(クロロホルム中、1×10 -7mol/1)、膜の発光極大波長418nm、吸収極 大波長344nm、ガラス転位温度70℃。

#### 【0071】実施例8

洗浄したITO基板上に、Baytron P (PED OT/PSS溶液(ポリ(3,4) エチレンジオキシチ 30 オフェンーポリスチレンスルホン酸ドープ体) /バイエ ル社製)を1000rpm、30秒でスピンコートした\*

\*後、150℃で1.5時間真空乾燥し、ホール注入/輪 送性膜を作成した(膜厚約100mm)。この上に試験 用化合物 1:試験用化合物 2:例示化合物 5=8 mg: 30.4mg:1.6mgの混合物をキシレン4mlに 溶かした溶液をスピンコート(1000rpm、20 秒)した(膜厚約50nm)。次いでこの有機薄膜上に パターニングしたマスク (発光面積が5mm×5mmと なるマスク)を設置し、蒸着装置内でカルシウムを膜厚 250nmで蒸着した後、アルミニウムを膜厚300n mで蒸着し(1.0×10<sup>-3</sup>Pa~1,3×10<sup>-3</sup>P a)、発光素子を作成した。

【0072】発光特性は以下のように測定した。東陽テ クニカ製ソースメジャーユニット2400型を用いて、 ITOを陽極、カルシウム:アルミニウムを陰極として 直流定電圧を発光素子に印加し発光させ、輝度をトプコ ン社の輝度計BM-8、発光波長を浜松フォトニクス社 製スペクトルアナライザーPMA-11を用いて測定し た。また、高温保存時の耐久性を評価するために、作製 した素子を60℃、20%相対湿度の条件下で3時間放 置後に発光させて相対輝度(駆動電圧10Vで、素子作 製直後の輝度を100とし、経時後輝度を相対値として 表示)を測定した。測定結果は以下のとおりである。最 低駆動電圧 (発光が観測される最低の電圧) は3 Vで、 10Vにおいて1145mA/cm2の電流密度を示 し、2290cd/m2の輝度で非常に色純度の良い濃 青色発光を示した。最大発光波長 Amaxは435n m、半值幅 4 2 nm、色度座標(0.159,0.10 4) 、外部量子効率 0. 21%であった。経時後の相対 輝度は85であった。 [0073]

- [(E.1.13

試際化合物2。

試験化合物1.

【0074】実施例9

実施例8の例示化合物5を例示化合物4に代えた以外は 実施例8と同様にして素子を作成した。発光特性は実施 例8と同様に測定した。測定結果は以下のとおりであ

る。最低駆動電圧(発光が観測される最低の電圧)は3 Vで、13Vにおいて1605mA/cm2の電流密度 を示し、1762cd/m2の輝度で非常に色純度の良 50 い濃青色発光を示した。最大発光波長 Amax は 4 3 4 nm、半値幅 4 9 nm、色度座標 (0. 154,0.0 69)、外部量子効率 0. 19%であった。経時後の相対頻度は 8 7であった。

### 【0075】実施例10

実施例 8 の例示化合物 5 を例示化合物 1 に代えた以外は 実施例 8 と同様にして素子を作成した。発光特性は実施 例 8 と同様に加定した。測定結果は以下のとおりであ 。最低駆動電圧(発光が振測される最低の電圧)は3 Vで、1 1 Vにおいて2 0 8 5 m A / c m 2 の電流密度 を示し、2 5 6 0 c d / m 2 の輝度で非常に色純度の良い濃青色発光を示した。最大発光波長 2 m a x は 4 3 4 m m、半値幅 4 3 n m、色度座標 (0. 1 5 5, 0. 0 6 2)、外部量子効率0、3 3 %であった。経時後の相 対輝度は 8 9 であった。

### 【0076】 比較例 1

実施例8の例示化合物5を公知化合物の試験化合物2に 代えた以外は実施例8と同様にして業子を作成した。発 光特性は実施例8と同様に測定した。測定結果は以下の とおりである。最低駆動電圧(発光が観測される最低の とおりである。最低駆動電圧(発光が観測される最低の 電圧)は5 Vで、10 Vにおいて65 mA/c m²の電流密度を示したに過ぎず、9 7 c d /m²の輝度を示したに過ぎなかった。また発光色は淡青~青緑色であった。極大発光波長 2 mm と483 nm、半値幅125 nmの発光を示し、溶液での発光特性から大きく変化してしまった(溶液での発光物、26 km、半値幅は14 nmであり、色度座標は15 常に色純度の低下した(0.178,0.264)を示した。外部量子効率は0.01%に過ぎなかった(10 V、9 7 c d /m²で湖定)。経時後の相対輝度は65であった。

## [0077]

【発明の効果】上記の結果より、本発明の化合物を使用する事で、高輝度を示し、ポツマー主劇間の相互作用によるエキサイマー形成を阻害して良好な色味度の裏子を作成できることが明らかになった。 更に高温保管後の輝度底下が小さく耐久性に優れた素子を提供できる。また整布プロセスによる積層型素子の作成が実現でき、実用上有用である。

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| ☐ BLACK BORDERS                                       |
|---|
| $\square$ image cut off at top, bottom or sides       |
| ✓ FADED TEXT OR DRAWING                               |
| ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING                |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES                               |
| $\square$ color or black and white photographs        |
| ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS                                |
| LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT                   |
| REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
| □ OTHER.  |

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.